

応用物理学会シリコンテクノロジー分科会多層配線システム研究委員会主催  
(電子情報通信学会 シリコン材料・デバイス研究会 (SDM) 共催)

## 配線技術研究集会

日時：平成24年3月5日(月) 10:00 - 16:30

会場：機械振興会館 地下3階 研修1号室

詳細は <http://www.jspmi.or.jp/about/access.html> をご覧ください。

交通 東京メトロ日比谷線 神谷町駅下車 徒歩8分

都営地下鉄三田線 御成門駅下車 徒歩8分

都営地下鉄大江戸線 赤羽橋駅下車 徒歩10分

都営地下鉄浅草線、大江戸線 大門駅下車 徒歩10分

JR山手線、京浜東北線浜松町駅下車 徒歩15分

担当：多層配線システム研究委員会

テーマ：「配線新技術と関連デバイス材料の動向」

参加費(予定)：1000円

### ◆プログラム◆

0. (10:00-10:05)

開会の挨拶

1. (10:05-10:50)

基調講演

BEOLプロセスを用いた超低電圧デバイスの開発

木村 紳一郎

超低電圧デバイス技術研究組合

2. (10:50-11:20)

Low-k/Cu配線層にシリンドラキャパシタを内包したロジックIP準拠・混載DRAMデバイスの性能評価

久米 一平, 井上 尚也, 肱岡 健一郎, 川原 潤, 武田 晃一, 古武 直也, 白井 浩樹, 風間 賢也,  
桑原 慎一, 渡會 雅敏, 佐甲 隆, 高橋 寿史, 小倉 卓, 泰地 稔二, 笠間 佳子, 坂本 美里, 羽根 正  
巳, 林 喜宏

ルネサスエレクトロニクス

3. (11:20-11:50)

InGaZnOチャネルの酸素制御とGate/Drain Offset構造によるBEOLトランジスタの高信頼化

金子 貴昭, 井上 尚也, 齋藤 忍, 古武 直也, 砂村 潤, 川原 潤, 羽根 正巳, 林 喜宏

ルネサスエレクトロニクス

■ 昼食 11:50- 13:00

4. (13:00-13:30)

ラマン分光法およびXPSによるSiO<sub>2</sub>/Si基板上での多層グラフェン成長初期の研究  
尾白 佳大, 小川 修一, 犬飼 学, 佐藤 元伸, 池永 栄司, 室 隆桂之, 二瓶 瑞久, 高桑 雄二, 横山 直樹  
東北大学多元物質科学研究所

5. (13:30-14:00)

ALD/CVDによる次世代Cu配線用単層バリヤ/ライナーCo(W)膜,  
清水 秀治 1)2), 嶋 紘平 1), 百瀬 健 1), 小林 芳彦 2), 霜垣 幸浩 1)  
大陽日酸 1), 東京大学 2)

6. (14:00-14:30)

微小流路型反応器を利用した銅めっき液中添加剤作用の解析  
齊藤 丈靖, 宮本 豊, 服部 直, 岡本 尚樹, 近藤 和夫  
大阪府立大学大学院工学研究科

■ 休憩 14:30-14:55

7. (14:55-15:25)

3次元実装TSVへのコンフォーマル無電解バリアメタルの形成  
有馬 良平, 三宅 浩, 井上 史大, 清水 智弘, 新宮原 正三  
関西大学理工学研究科

8. (15:25-15:55)

Si貫通ビア (TSV)の側壁ラフネスに起因したリーク電流特性とビア応力の関係  
北田 秀樹 1)2), 前田 展秀 1), 藤本 興治 1), 児玉 祥一 1), 金 永東 1), 水島 賢子 1)2), 中村 友二 2), 大場 隆之 1)  
東京大学 1)、富士通研究所 2)

9. (15:55-16:25)

Wafer-on-wafer構造における貫通Si電極周辺の局所歪の評価  
中塚 理 1), 北田 秀樹 2), 金 永東 2), 水島 賢子 3), 中村 友二 3), 大場 隆之 2), 財満 鎮明 1)  
名古屋大学 1)、東京大学 2)、富士通研究所 3)

0. (16:25-16:30)

閉会の挨拶